

а 2008 0129

Изобретение относится к полупроводниковым приборам, в частности к газовым датчикам, и может быть использовано для детектирования токсичных газов в атмосфере.

Газовый датчик на основе стеклообразных халькогенидных полупроводников содержит изолирующую подложку, на которой последовательно расположены газочувствительный слой на основе халькогенидного стеклообразного полупроводника, полученный методом испарения в вакууме  $As_2S_3$ ,  $As_2Se_3$  или их твердых растворов, и два электрода. При этом газочувствительный слой имеет рельефную поверхность строгой периодичности, выполненную в виде дифракционной решетки голографическим методом.

П. формулы: 1

Фиг.: 3